

# RD2.0S ~ RD150S

## 200 mW プレーナ形 2 ピン小型ミニモールド 定電圧ダイオード

RD2.0S ~ RD150S は許容損失 200 mW のプレーナ形定電圧ダイオードです。本素子は高密度実装用に小型化したものです。

### 特 徴

従来ミニモールド RD [ ] M と比較して小型（実装面積約 38%）のため高密度実装に最適です。

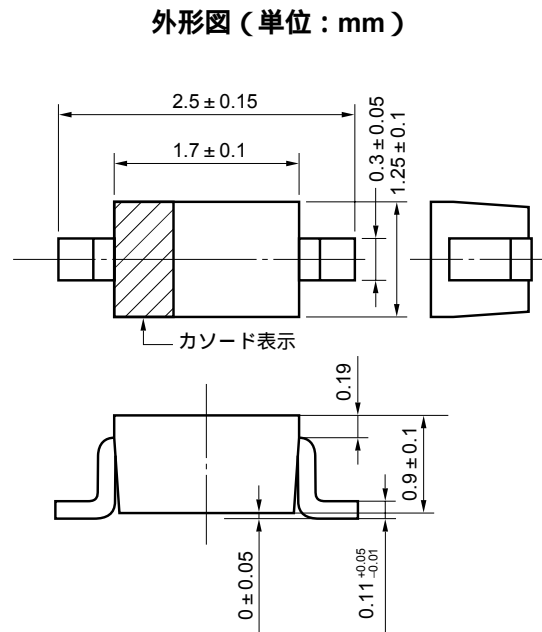
基準電圧・検出回路応用として、ツェナー電圧 2.7 ~ 12 V の範囲は電圧区分を導入しております。

2 ピン・ミニモールドのため、基板設計が容易です。

BX・BY の電圧区分の新設により、敏速納入が容易です。

- ・ BX: B1 または B2 のいずれかの電圧区分でご納入致します。
- ・ BY: B2 または B3 のいずれかの電圧区分でご納入致します。

### 用 途



### 電圧区分情報

- 基準電圧応用 . . . . . B1・B2・B3・BX・BY  
 波形クリップ回路，リミッタ回路応用 . . . . . B1・B2・B3・BX・BY  
 サージ吸収応用 . . . . . B

### 絶対最大定格 (T<sub>A</sub> = 25°C)

項 目	略 号	定 格	単 位	備 考
許容損失	P	200	mW	図 1 参照
サージ逆電力	P <sub>RSM</sub>	85	W	t = 10 μs/ 1 パルス 図 6 参照
順電流	I <sub>F</sub>	100	mA	
接合部温度	T <sub>j</sub>	150	°C	
保存温度	T <sub>stg</sub>	-55 ~ + 150	°C	

本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

品名	規格	ツェナー電圧 $V_z$ (V) 注1		動作抵抗 $Z_z$ ( $\Omega$ ) 注2		逆電流 $I_R$ ( $\mu A$ )		ツェナー電圧 温度係数 $\gamma_z$ (mV/°C)		
		MIN.	MAX.	$I_z$ (mA)	MAX.	$I_z$ (mA)	MAX.	$V_R$ (V)	TYP.	$I_z$ (mA)
RD12S	B	11.38	12.64	5	35	5	2	9.0	8.0	5
	B1	11.38	11.94							
	B2	11.69	12.28							
	B3	12.04	12.64							
	BX	11.38	12.28							
	BY	11.69	12.64							
RD13S	B	12.43	14.00	5	35	5	2	10	9	5
	B1	12.43	13.07							
	B2	12.87	13.53							
	B3	13.33	14.00							
RD15S	B	13.80	15.56	5	40	5	2	11	10	5
	B1	13.80	14.50							
	B2	14.30	15.02							
	B3	14.81	15.56							
RD16S	B	15.31	17.14	5	40	5	2	12	12	5
	B1	15.31	16.07							
	B2	15.78	16.58							
	B3	16.30	17.14							
RD18S	B	16.89	19.08	5	45	5	2	13	13	5
	B1	16.89	17.75							
	B2	17.51	18.40							
	B3	18.16	19.08							
RD20S	B	18.80	21.14	5	50	5	2	15	15	5
	B1	18.80	19.76							
	B2	19.46	20.45							
	B3	20.15	21.14							
RD22S	B	20.81	23.25	5	55	5	2	17	17	5
	B1	20.81	21.84							
	B2	21.46	22.55							
	B3	22.15	23.25							
RD24S	B	22.86	25.66	5	60	5	2	19	20	5
	B1	22.86	24.03							
	B2	23.65	24.85							
	B3	24.45	25.66							
RD27S	B	25.10	28.90	2	70	2	2	21	22	2
RD30S	B	28.00	32.00	2	80	2	2	23	26	2
RD33S	B	31.00	35.00	2	80	2	2	25	29	2
RD36S	B	34.00	38.00	2	90	2	2	27	32	2
RD39S	B	37.00	41.00	2	100	2	2	30	36	2

注1. ツェナー電圧 ( $V_z$ ) は、通電後40 msで測定します。

2. 動作抵抗 ( $Z_z$ ) は、規定電流 ( $I_z$ ) に微小交流電流を重畳して測定します。

備考 B規格はB1, B2, B3規格を総合した規格です。B規格品のご要求には、B1, B2, B3いずれかの規格品にてお応えします。

特性曲線 (  $T_A = 25^\circ\text{C}$  )

図1 P -  $T_A$  定格

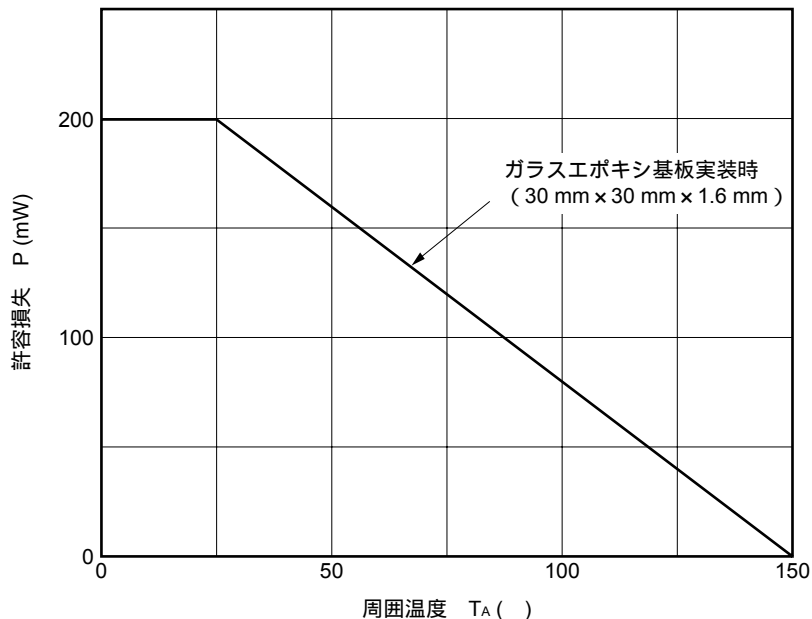
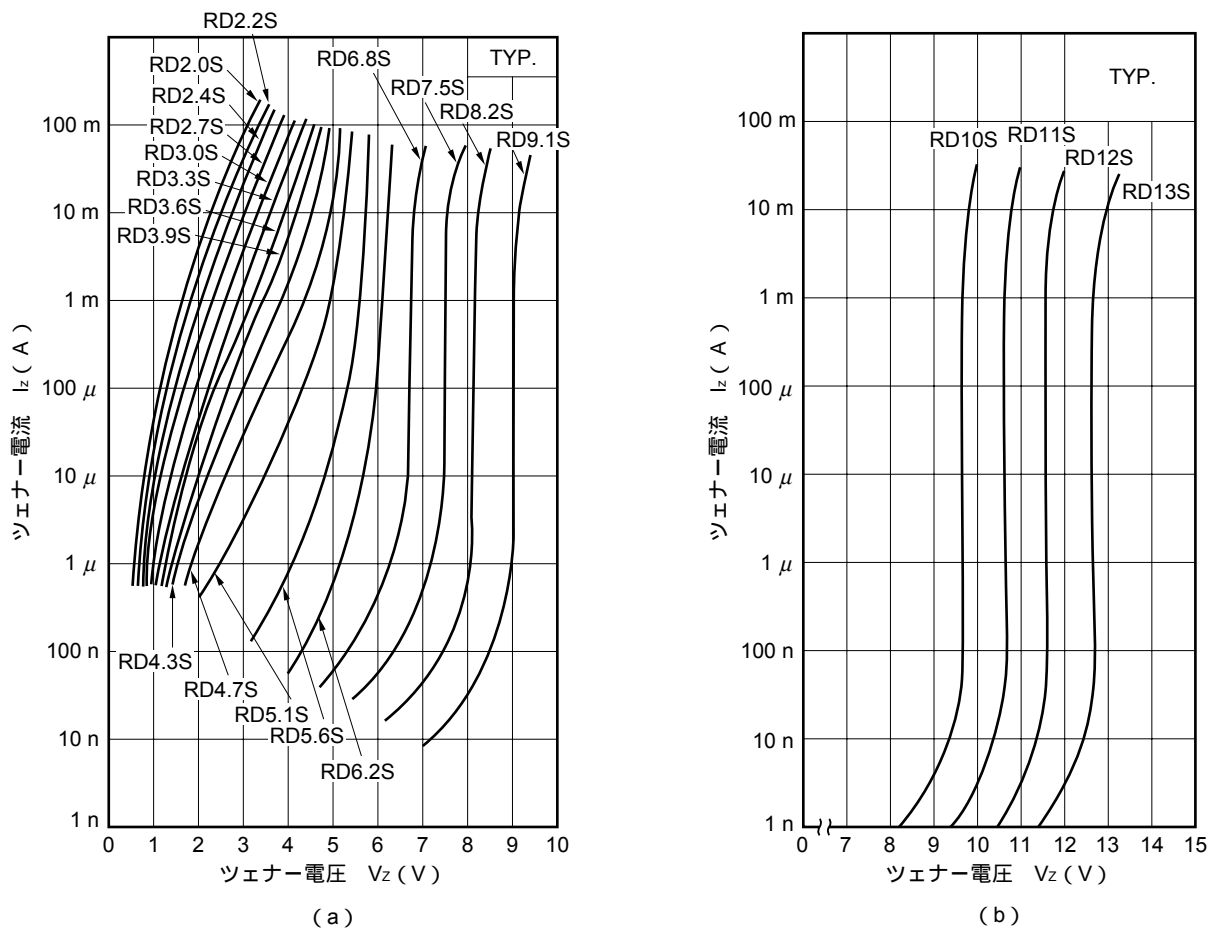
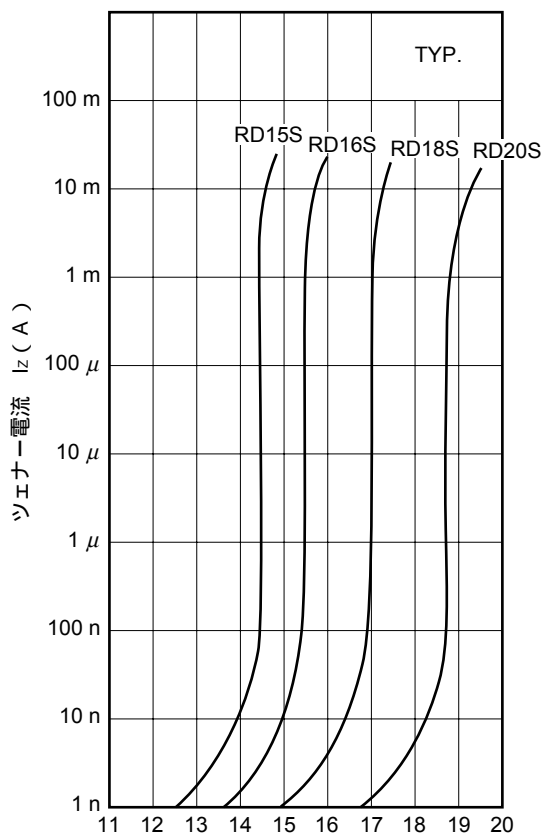
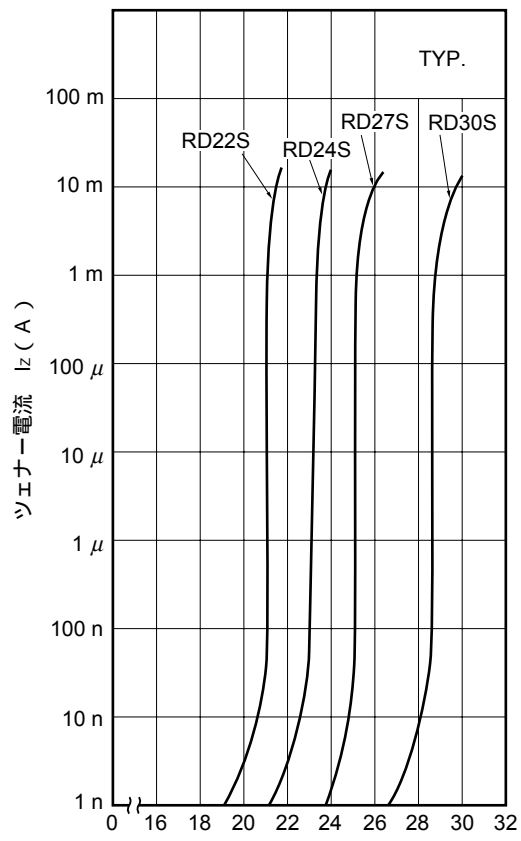


図2  $V_z - I_z$  特性例

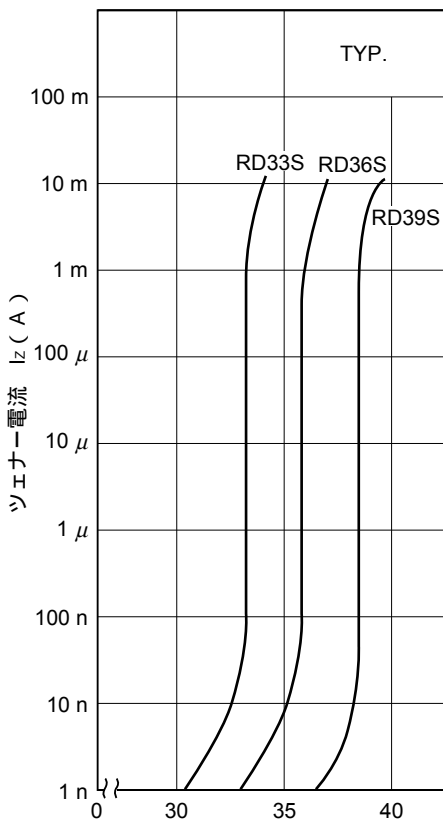




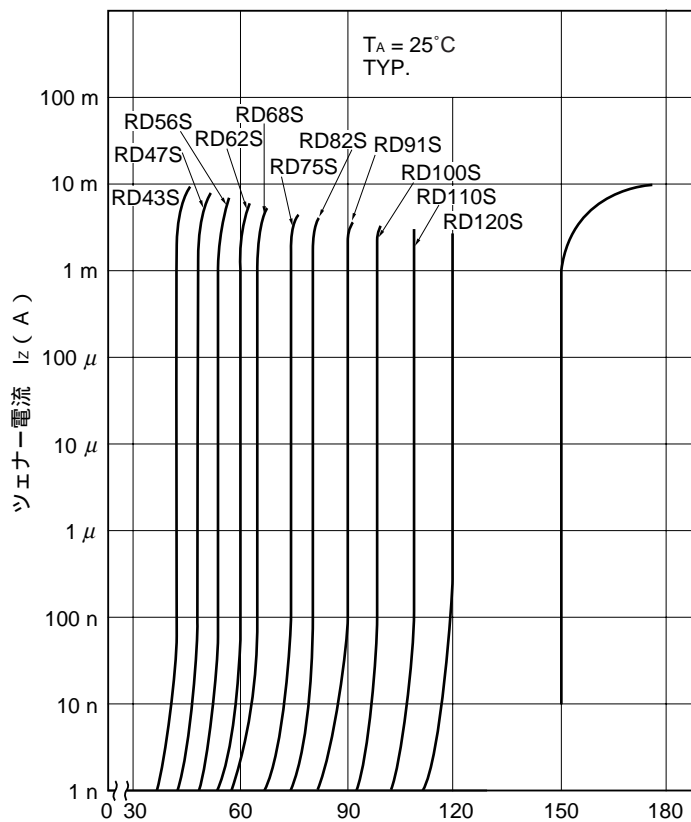
(c)



(d)



(e)



(f)

図3  $Z_z - I_z$  特性例

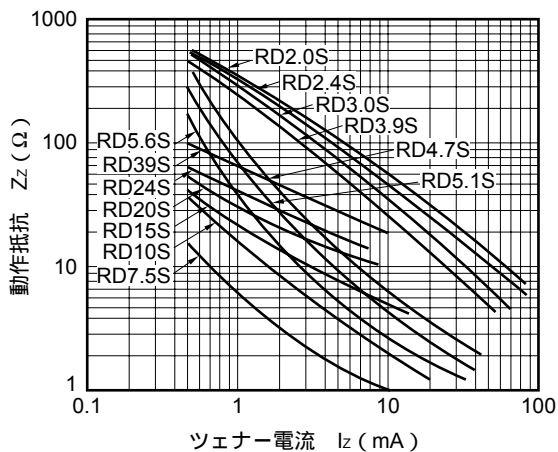


図4  $V_z - \gamma_z$  特性例

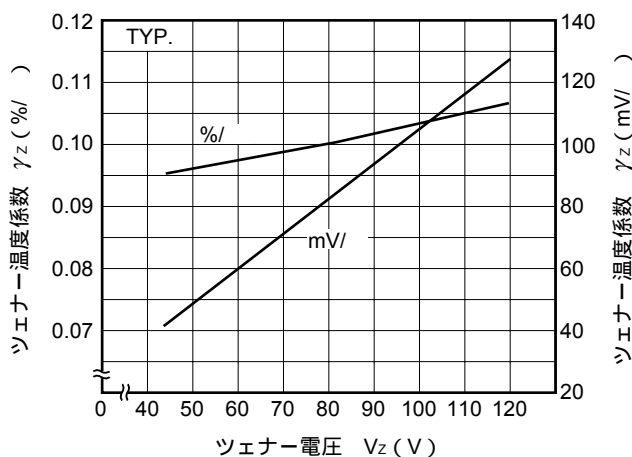
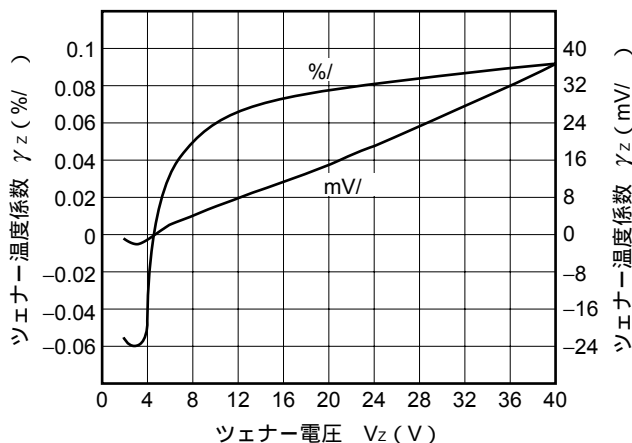


図5 過渡熱インピーダンス特性

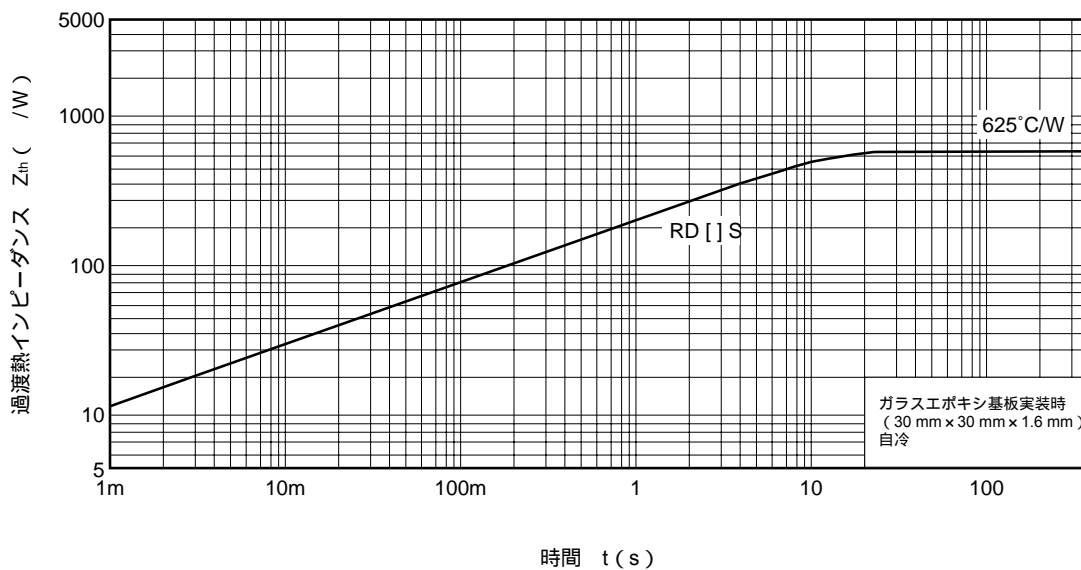


図6 サージ逆電力定格

